

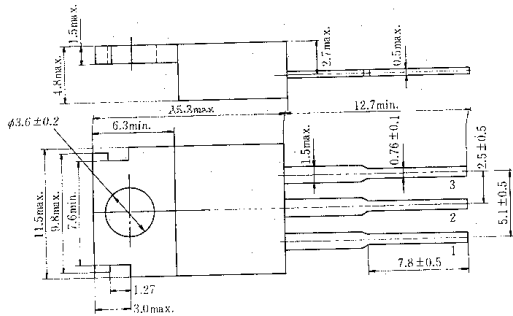
# 2SC1723

シリコン NPN 三重拡散 LTP 形

低周波高電圧電力増幅用  
TV 電源励振用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED LTP

LOW FREQUENCY HIGH VOLTAGE POWER  
AMPLIFIER  
TV POWER SUPPLY DRIVER



1. ベース: Base
  2. コレクタ: Collector  
(フランジ) (Flange)
  3. エミッタ: Emitter
- (Dimensions in mm)

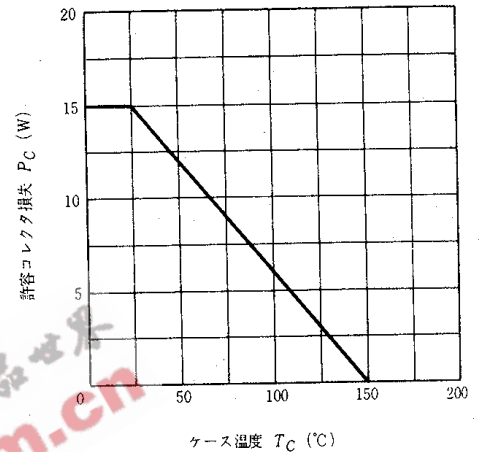
(JEDEC TO-220AB)

## ■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	2SC1723	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	300	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	300	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
コレクタ電流	$I_C$	0.2	A
許容コレクタ損失	$P_C^*$	15	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-45~+150	$^\circ\text{C}$

\*  $T_C=25^\circ\text{C}$  における許容値  
\* Value at  $T_C=25^\circ\text{C}$

## 許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE

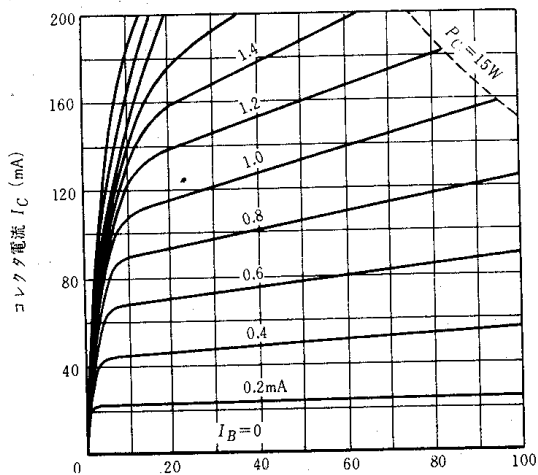


## ■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	300	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=5\text{mA}, R_{BE}=\infty$	300	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}, I_C=0$	5	—	—	V
コレクタ遮断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=250\text{V}, I_E=0$	—	—	0.1	$\mu\text{A}$
	$I_{CEO}$	$V_{CE}=250\text{V}, R_{BE}=\infty$	—	—	2	$\mu\text{A}$
直流電流増幅率	$h_{FE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	40	—	200	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	0.32	1.5	V
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}$	—	0.66	0.9	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE}=20\text{V}, I_C=30\text{mA}$	—	60	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=50\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	6.2	8	pF

### エミッタ接地出力静特性

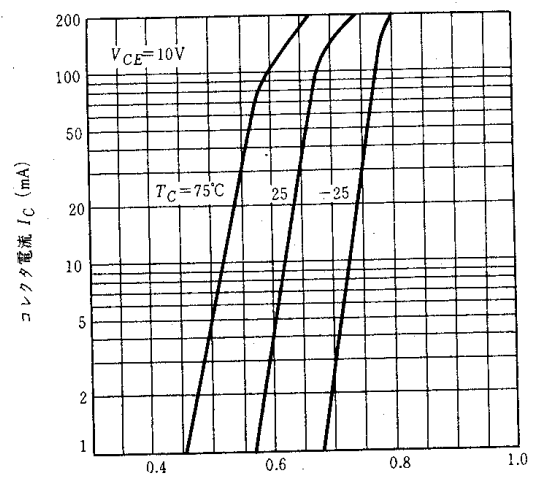
#### TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS



コレクタ・エミッタ電圧  $V_{CE}$  (V)

### エミッタ接地伝達静特性

#### TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS



ベース・エミッタ電圧  $V_{BE}$  (V)